К. т. н. А. А. ЕФИМЕНКО, В. В. ШАТАЛОВ

Украина, г. Одесса, Нац. политехнический ун-т, OOO «Телекарт-Прибор» E-mail: `kpra@rtf.ospu.odessa.ua

Дата поступления в редакцию 12.05 2003 г. — 05.07 2004 г. Оппонент к. т. н. Э. Н. ГЛУШЕЧЕНКО (НПП "Сатурн", г. Киев)

МОДЕЛИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЦЕПЯХ

Рассмотрены особенности использования низкочастотных соединителей в высокочастотных цепях с учетом влияния перекрестных помех и согласования волнового сопротивления.

Современная электронная аппаратура (ЭА) характеризуется высокими частотами передаваемых сигналов, большим количеством линий связи и разъемных соединений. Электрические соединители, включаемые в эти линии связи, должны отвечать повышенным требованиям к параметрам, в том числе по постоянству импеданса и защите от перекрестных помех.

Наилучшим образом этим требованиям удовлетворяют коаксиальные соединители. Их применение практически исключает проникновение перекрестных помех из одной сигнальной линии в другую. Однако при большом числе линий связи применение коаксиальных соединителей нетехнологично и ухудшает массогабаритные показатели ЭА.

Применение низкочастотных (НЧ) соединителей, которые технологически эффективнее при использовании, делает линию связи восприимчивой к перекрестным помехам между соседними сигнальными контактами. Вместе с тем НЧ-соединители все же используются и на более высоких частотах, чем это предписано техническими условиями (для большинства из них предельная частота составляет 3 МГц). Это решается в процессе конкретной разработки, и возможность использования НЧ-соединителей подтверждается, как правило, при отладке макетов или опытных образцов.

Некоторые разработчики уже в диапазоне 500—1000 кГц применяют и коаксиальные кабели, и НЧ-соединители — опасаясь необходимости переработки аппаратуры на более поздних стадиях и, соответственно, дополнительных затрат. Но это не значит, что использование НЧ-соединителей не даст нужного результата. Такая подстраховка вызвана тем, что разработчики по разным причинам не используют эффективный инструмент — моделирование.

Цель статьи — показать возможность применения низкочастотных соединителей в высокочастотных цепях и определить схемы включения соединителей, которые позволят использовать их в современной ЭА без ухудшения характеристик аппаратуры.

Используя методику, приведенную в [1], покажем схемы и электрические модели нескольких вариантов включения контактов соединителей (см. **puc. 1**):

- а) для одиночного изолированного контакта НЧ-соелинителей:
- б) для высокочастотных (ВЧ) соединителей (эта модель может применяться для моделирования НЧ-соединителей, когда контакты, расположенные рядом с сигнальным контактом, заземлены);
- в) для НЧ-соединителей, когда сигнальные контакты с источником помехи (ИП) и приемником помехи (ПП) находятся рядом;
- г), е) для НЧ-соединителей, когда сигнальные контакты с ИП и ПП находятся соответственно через один и через два рядом расположенных контакта;
- д), ж) аналогично предыдущим схемам и моделям контакты с ИП и ПП находятся соответственно через один и через два рядом расположенных контакта, но последние соединены с "землей".

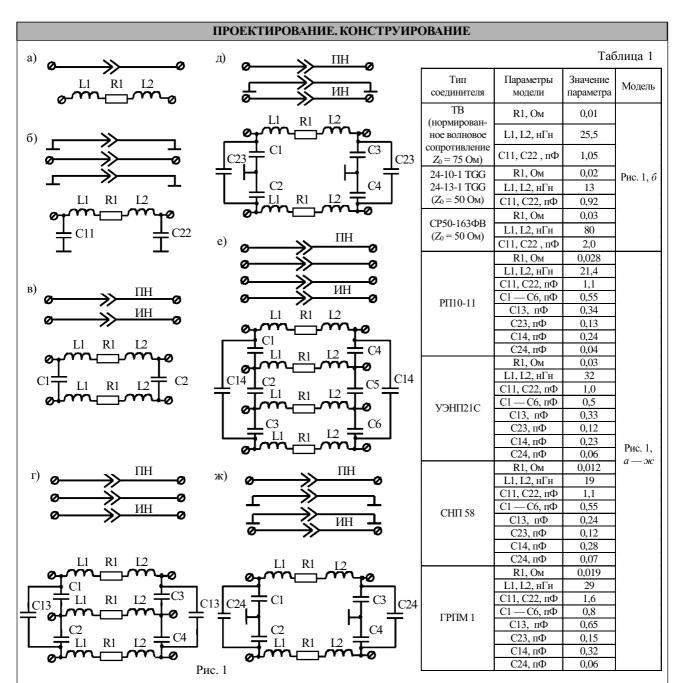
Электрические параметры контактов некоторых НЧ-и ВЧ-соединителей для построенных моделей представлены в $\tau aбл. 1$.

Моделирование разъемных соединителей проводилось на ПЭВМ с использованием системы схемотехнического моделирования Design Center (PSpice) [2]. Моделирование НЧ-соединителей проводилось по схеме рис. 1, α , ВЧ — по схеме рис. 1, δ .

Для НЧ- и ВЧ-соединителей построены АЧХ и ФЧХ, представленные на **рис. 2** и **3**, соответственно. В качестве нагрузки для ВЧ-соединителей использовался резистор с сопротивлением, равным волновому сопротивлению соединителя Z_L , а для всех низкочастотных соединителей использовался резистор сопротивлением 100 Ом.

1 у результатов моделирования видно, что АЧХ и ФЧХ НЧ- и ВЧ-соединителей близки, что позволяет предположить возможность использования НЧ-соединителей на высоких частотах порядка 10 МГц. Однако это не является достаточным условием с точки зрения взаимного влияния. Поэтому используя схемы включения контактов в качестве сигнальных, показанные на рис. 1, в—ж, проведено моделирование перекрестных помех между этими контактами. Результаты моделирования представлены на рис. 4—8.

Анализируя результаты моделирования перекрестных помех, можно сделать вывод о том, что простое



увеличение расстояния между сигнальными контактами за счет их использования через один и через два (рис. 5, 6) не дает существенных результатов по снижению перекрестных помех. В то же время заземление пропущенных контактов (рис. 7, 8) приводит к значительному подавлению помех по сравнению со случаем, когда контакты выбраны рядом.

При применении соединителей в цепях, которые можно отнести к длинным линиям, очень важно обеспечить согласование волнового сопротивления соединителя и линии связи во избежание отражений и, вследствие этого, искажений передаваемых сигналов

Волновое сопротивление исследуемых коаксиальных соединителей можно определить по формуле [3, с.131]

$$Z_L = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \frac{D}{d} \text{ OM},$$

где $\mathbf{\epsilon}_r$ — относительная диэлектрическая проницаемость среды (в нашем случае — материала диэлектрика соединителя);

 $D,\,d$ — диаметры соответственно экранирующего корпуса и центрального контакта.

Для низкочастотных соединителей [3, с. 137]

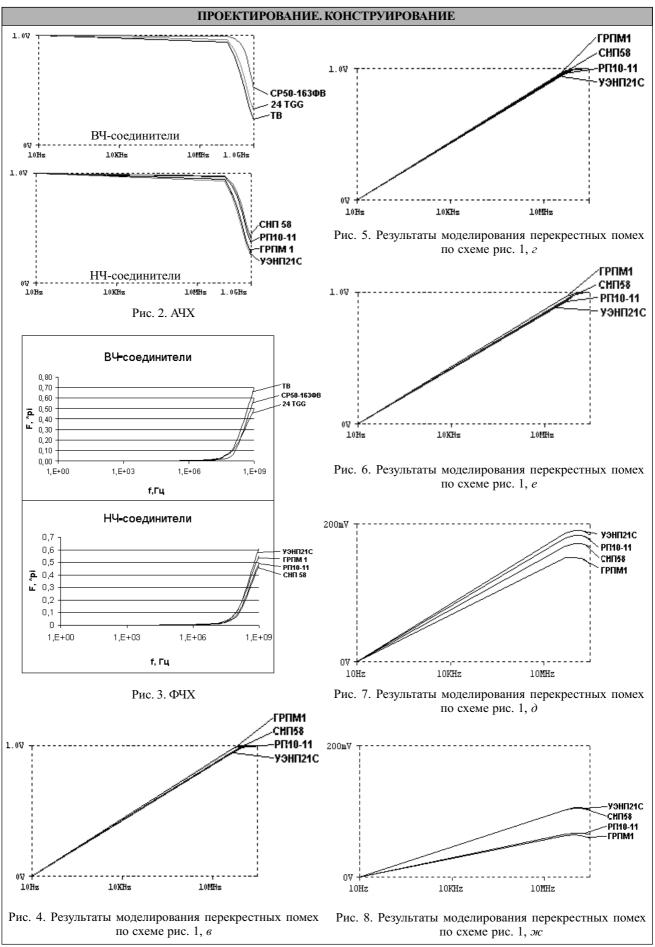
$$Z_L = \frac{120}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \frac{2a}{d} \text{ OM},$$

где d — диаметр выводов соединителя;

a — расстояние между центрами выводов соединителей, образующих линию связи.

Результаты расчета Z_L приведены в **табл. 2**.

Таким образом, предложенная методика с достаточной для практики точностью может быть использована для получения заданного значения Z_L при разработке соединителей. Отклонение волнового сопротивления ВЧ-соединителей не превышает 12%, что может быть вызвано допуском на значение этого параметра и погрешностью расчета.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ. КОНСТРУИРОВАНИЕ

Таблина 2

	·
Тип соединителя	Z_L , Ом
$TB (Z_0 = 75 O_M)$	69,3
24 -10-1 TGG, 24-13-1 TGG ($Z_0 = 50$ Ом)	55,9
${\rm CP}\ 50\text{-}163\Phi {\rm B}\ (Z_0=50\ {\rm Om})$	51,6
РП10-11	99,2
УЭНП21С	103,2
СНП 58	109
ГРПМ 1	81

Волновые сопротивления НЧ-соединителей можно привести к требуемым значениям путем применения материала изолятора с другой диэлектрической проницаемостью или путем изменения геометрических размеров контактов, а также за счет изменения расстояния между соседними контактами электрического соединителя.

В результате экспериментов было определено, что вилка ВЧ-соединителя имеет волновое сопротивление выше номинального, а розетка — ниже, но при их сочленении волновое сопротивление стремится к номинальной величине, т. е. отклонение Z_{I} от номинального значения составных частей компенсируется.

Основываясь на результатах моделирования, можно сделать вывод, что применение НЧ-соединителей на более высоких частотах, чем это определено техническими условиями, возможно при использовании рассмотренных схем включения, позволяющих снизить влияние перекрестных помех и искажение передаваемых сигналов, а также (в необходимых случаях) при приведении значения волнового сопротивления Z_I к заданному.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- 1. Ефименко А. А., Шаталов В. В. Моделирование разъемных контактов в электрических соединениях электронной аппаратуры // Технология и конструирование в электронной аппаратуpe.— 2001.— № 4—5.— C. 7—10.
- 2. Разевиг В. Д. Система схемотехнического моделирования и проектирования печатных плат Design center PSpice.— М.: СК Пресс, 1996.
- 3. Мейнке Х., Гундлах Ф. В. Радиотехнический справочник. Т. 1.— М.-Л.: Гос. энергетическое изд-во, 1960.

К. ф.-м. н. А. Г. ГОЛОВКО

г. Херсон, НПФ «Артур» E-mail: argo m@ukr.net

Дата поступления в редакцию 03.02 2004 г. Оппонент к. ф.-м. н. С. Д. ВОТОРОПИН (НИИПП, г. Томск)

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ БАРЬЕРАХ

Подтверждена справедливость установленной ранее закономерности флуктуационных преобразований в электронных приборах с нелинейными вольт-амперными характеристиками.

Любой процесс переноса зарядов сопровождается флуктуациями электрофизических параметров, в технической литературе обозначаемых как «шумы». Разработчикам электронной аппаратуры важно знать, каким образом будут проявляться флуктуации напряжения в элементах электрической цепи при изменении режимов смещения. Если для омических образцов известно, что для низкочастотных флуктуаций напряжения спектральная плотность $G_{\mu}(f)$ оказывается пропорциональной квадрату силы тока I, то для образцов с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ) такой зависимости в литературе раньше найти было невозможно [1—3]. Тем не менее, она была установлена автором еще в середине семидесятых годов прошлого столетия на основе исследований токовой зависимости флуктуаций в прямосмещенных барьерах Шоттки и *p*–*n*-переходах [4] и использована, например, для создания нового способа измерения тока насыщения барьеров Шоттки и *p*–*n*-переходов [4, 5].

Установленная функция преобразования флуктуаций была описана в нескольких публикациях, например, в [5—8]. Однако в наиболее удобном для восприятия виде она содержится в работах [9, 10]. Ее суть состоит в том, что мгновенная флуктуация электропроводности $\delta g(t)$, вызванная мгновенной флуктуацией концентрации носителей зарядов (электронов $-\delta n(t)$, дырок — $\delta p(t)$) или (и) их подвижности $\delta\mu(t)$, преобразуется во флуктуации падения напряжения $\delta u(t)$ на образце с нелинейной BAX согласно простому соотношению [10, ф-ла (3)]

$$\delta u(t) = \delta g(t) r_d U, \tag{1}$$

где $\ r_d$ — дифференциальное сопротивление образца; $\ U$ — падение напряжения на образце.

Можно применить к флуктуирующим параметрам Фурье-анализ и получить для соответствующих спектральных плотностей соотношение

$$G_{\nu}(f) = G_{\sigma}(f)(r_{\nu}U)^{2}.$$
 (2)

Для текущих спектров S(f) это равнозначно соотношению [10]

$$S_{u}(f) = S_{o}(f)r_{d}U. \tag{3}$$

Характер токовой зависимости шумов в соответствии с (3) наглядно демонстрируют графики, приведенные в работе [9]. Для барьеров Шоттки и р-n-пе-